

SAMSUNG

990 EVO Plus

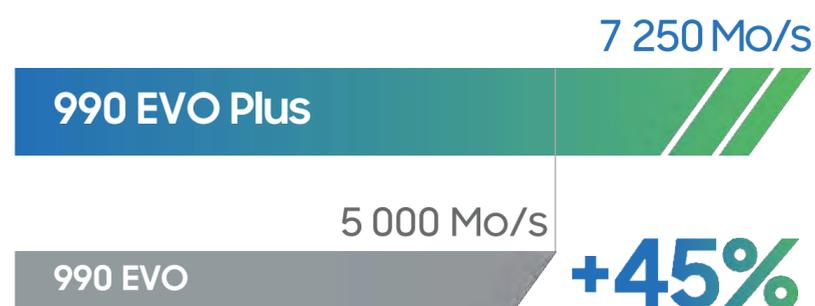
Améliorez vos performances quotidiennes



Vitesse remarquable

Accélérez vos tâches.

Le 990 EVO Plus atteint des vitesses de lecture et d'écriture fulgurantes de 7 250 Mo/s et 6 300 Mo/s¹ grâce à la dernière NAND, ce qui améliore les performances de 45 %² par rapport au modèle précédent. Accélérez le chargement des jeux et accédez plus rapidement à des fichiers volumineux.



 Lecture séquentielle
jusqu'à **7 250 Mo/s**

 Écriture séquentielle
jusqu'à **6 300 Mo/s**

 Lecture aléatoire
jusqu'à **1 050K IOPS**

 Écriture aléatoire
jusqu'à **1 400K IOPS**

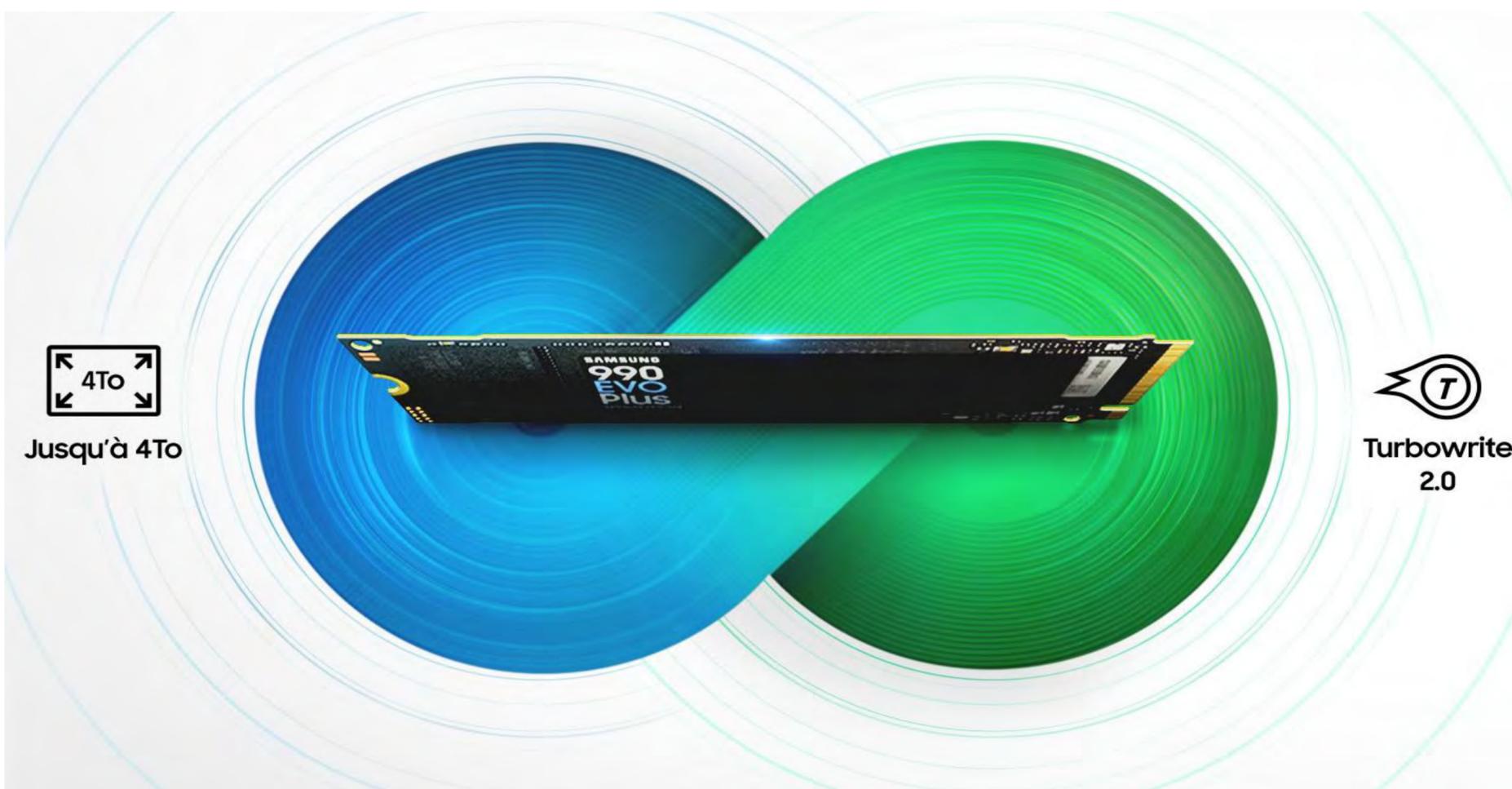
Restez au frais même avec des performances fulgurantes

Une puissance constante, des performances plus efficaces. Avec le contrôleur en nickel, le 990 EVO Plus est 73 %³ plus économe en énergie par watt. Atteignez le même niveau de puissance en consommant moins d'énergie et en évitant les ralentissements dus à la chaleur.



Maxi stockage. Maxi vitesse. Maxi potentiel.

Exploitez toute la puissance de votre SSD grâce à la technologie Intelligent TurboWrite 2.0. Traitez plus rapidement les données et les graphiques lourds avec un TurboWrite élargi, désormais disponible jusqu'à 4 To.



Spécifications techniques

		990 EVO Plus		
Référence		MZ-V9S1T0	MZ-V9S2T0	MZ-V9S4T0
Caractéristiques générales	Capacité**	1To	2To	4To
	Facteur de forme	M.2 (2280)		
	Interface	PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0*		
	Dimension	Max 80,15 x Max 22,15 x Max 2,38 (mm)		
	Poids	Max 9.0g		
	Mémoire de Stockage	Samsung V-NAND TLC		
	Controller	Samsung in-house Controller		
Performance***	Lecture séquentielle (Mo/s)	7 150	7 250	7 250
	Écriture séquentielle (Mo/s)	6 300	6 300	6 300
	Lecture aléatoire (IOPS, QD32)	850K	1 000K	1 050K
	Écriture aléatoire (IOPS, QD32)	1 350K	1 350K	1 400K
Logiciel	Logiciel de gestion	Samsung Magician software		
Garantie****	TBW	600	1 200	2 400
	Durée	5 ans		

* La marque de conception NVMe™ est une marque déposée de NVM Express, Inc.

** 1 Go = 1 000 000 000 octets selon IEC. Une certaine partie de la capacité peut être utilisée pour le système et la maintenance, de sorte que la capacité réelle peut différer de ce qui est indiqué sur l'étiquette du produit.

*** Les performances d'écriture séquentielle et aléatoire ont été mesurées avec la technologie Intelligent Turbo Write activée. La technologie Intelligent Turbo Write ne fonctionne que dans le cadre d'une taille de transfert de données spécifique. Les performances peuvent varier en fonction du firmware du SSD, du matériel et de la configuration du système et d'autres facteurs.

**** Cinq ans ou le nombre total d'octets écrits (TBW), au premier des deux termes échus. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez vous référer au document de garantie joint à l'emballage.

¹ Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système.

² 990 EVO Plus lecture/écriture séquentielle - 7250/6300 Mo/s, 990 EVO lecture/écriture séquentielle - 5000/4200 Mo/s d'après les résultats des tests internes du modèle d'une capacité de 2 To. Les résultats des tests peuvent varier en fonction des conditions et de l'environnement.

³ 990 EVO lecture/écriture séquentielle - 909/893 Mo/s par Watt, 990 EVO Plus lecture/écriture séquentielle 1576/1500 Mo/s par Watt basé sur les résultats des tests internes du modèle d'une capacité de 2To. Les résultats des tests peuvent varier en fonction des conditions et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur le SSD de Samsung, visitez samsung.com/ssd

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. Les spécifications et les conceptions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs. Toutes les données ont été jugées correctes au moment de la création. Samsung n'est pas responsable des erreurs ou des omissions. Tous les noms et logos de marques, de produits et de services sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.